

Этикетка

Микросхема 1564ЛС3ТЭП

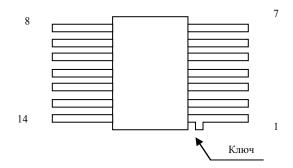
КСНЛ.431272.002 ЭТ

Микросхема интегральная 1564ЛС3ТЭП Функциональное назначение:

Два независимых элемента «2И-2И-ИЛИ» и «3И-3И-ИЛИ»

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов Номера выводов показаны условно Масса не более 1 г.



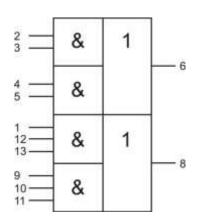


Таблица назначения выводов

| № | Обозначение | Назначение | № | Обозначение | Назначение |
|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| вывода | вывода | вывода | вывода | вывода | вывода |
| | | _ | _ | | |
| 1 | A1 | Вход | 8 | Y1 | Выход |
| 2 | A2 | Вход | 9 | D1 | Вход |
| 3 | B2 | Вход | 10 | E1 | Вход |
| 4 | C2 | Вход | 11 | F1 | Вход |
| 5 | D2 | Вход | 12 | B1 | Вход |
| 6 | Y2 | Выход | 13 | C1 | Вход |
| 7 | 0V | Общий | 14 | V_{CC} | Питание |

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при $t = 25\pm10$ °C)

| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Буквенное | Норма | |
|--|----------------------|----------|----------|
| | обозначение | не менее | не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: | | | |
| U_{CC} =2,0 B, U_{IL} =0,3 B, U_{IH} =1,5 В I_{O} = 20 мкА | U _{OL max} | - | 0,10 |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B, I_{O} = 20 MKA | | - | 0,10 |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 20 MKA | | - | 0,10 |
| при: | | | |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B, I_{O} =4,0 MA | | - | 0,26 |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 5,2 mA | | - | 0,26 |
| 2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: | | | |
| U_{CC} =2,0 B, U_{IL} =0,3 B, U_{IH} =1,5 B I_{O} = 20 mkA | U_{OHmin} | 1,9 | - |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B, I_{O} = 20 mkA | | 4,4 | - |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 20 MKA | | 5,9 | - |
| при: | | | |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B, I_{O} =4,0 MA | | 4,0 | - |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 5,2 mA | | 5,5 | - |
| 3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: | | | |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = U_{CC}$ | ${ m I}_{ m IL}$ | - | /-0,1/ |

| 4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC}\!=\!6,\!0~B,U_{IL}\!=\!0~B,U_{IH}\!=\!U_{CC}$ | I_{IH} | - | 0,1 |
|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 5.Ток потребления, мкА, при: $U_{CC}\!\!=\!6,\!0$ B, $U_{IL}\!\!=\!0$ B, $U_{IH}\!\!=\!\!U_{CC}$ | I_{CC} | - | 2,0 |
| 6. Динамический ток потребления, мА, при: $U_{CC}\!=\!6,\!0\;B,f\!=\!10,\!0\;M\Gamma_{I\!I}$ | I _{occ} | - | 20,0 |
| 7. Время задержки распространения при включении и выключении , нс, при: $U_{CC}=2,0 \ B, \ C_L=50 \ \pi\Phi$ $U_{CC}=4,5 \ B, \ C_L=50 \ \pi\Phi$ | t _{PHL,} t _{PLH} | - | 125 25 |
| $U_{CC} = 6,0 \; B, \; C_L = 50 \; \Pi \Phi$ 8. Входная емкость, $\Pi \Phi$ | C _I | - | 10 |

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото г.

серебро г.

в том числе:

золото г/мм

на 14 выволах ллиной мм

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых

ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) $^{\circ}$ C не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при $U_{CC} = 5B \pm 10\%$ - не менее 135000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{C\gamma}$) при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных,- в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям AEЯР.431200.424-30ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564ЛСЗТЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-30ТУ и признаны годными для эксплуатации.

| Приняты по | OT | | |
|----------------------|---------------------|--------|---------------------|
| (извещение | е, акт и др.) | (дата) | |
| Место для штампа ОТ | | | Место для штампа ПЗ |
| Место для штампа « П | ерепроверка произве | дена | » |
| | от | (дата) | - |
| Место лля штампа ОТ | K | | Место лля штампа П |

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общий, вход-питание.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ.